# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

#### **3BIT**

з основ сучасної електроніки Тема: «Дослідження ВАХ діодів»

Виконав студент 5-б групи другого курсу фізичного факультету спеціальності «Фізика» Гречиха О.С. УДК 001.002 (008.21) ББК 73Ц I-72

Укладачі: Гречиха О.С.

I-72 Звіт. Дослідження ВАХ діодів. / укл. О.С. Гречиха.— К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021.-10 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмах NI Multisim.

УДК 001.008 (002.21) ББК 73Ц

© Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2021

## Зміст

Вступна частина	4
1. Об'єкт дослідження	
2. Мета	
3. Метод вимірювання	4
Теоретична частина	
Практична частина	
1.Фільтр низьких частот	
2.Фільтр високих частот	
3.Загороджувальний фільтр	
Висновок	
Список використаних джерел	

## Вступна частина

Об'єкт дослідження: напівпровідникові діоди.

<u>Мета роботи</u>: навчитися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості p-n-переходів напівпровідникових діодів різних типів.

**Метод вимірювання**: 1) одержання зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі *характериографа*; 2) побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму  $I_{\rm Д}$ , що відповідають певним значенням та полярності напруги  $U_{\rm Д}$ , і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

#### Теоретична частина

**Напівпровідниковий** д**іод** (англ. *semiconductor diode*) — це напівпровідниковий прилад з одним *p-n-переходом* і двома виводами.

p-n-перехід (англ. p-n junction) — перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша — провідність p-типу.

**Вольт-амперна характеристика (ВАХ)** діода (англ. *current-voltage characteristic*) — це залежність сили струму  $I_{\partial}$  через p-n—перехід діода від величини і полярності прикладеної до діода напруги  $U_{\partial}$ .

**Характериограф** — електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму  $I_{\partial}$  від напруги  $U_{\partial}$ .

#### Практична частина

Усі параметри моделювання задані згідно з джерелом (2), окрім частоти.

#### 1) Схема

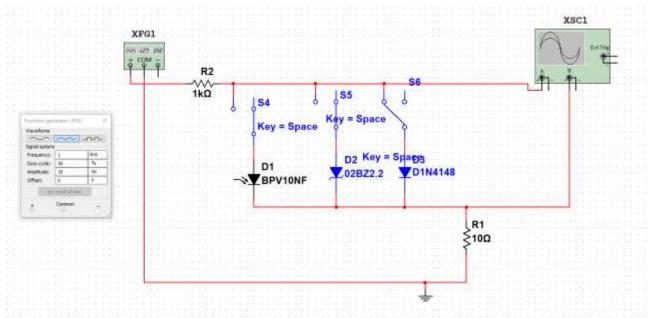


Рисунок 1.1. Схема для моделювання ВАХ діодів та параметри генератора функцій

#### 2) Вольт-амперні характеристики діодів

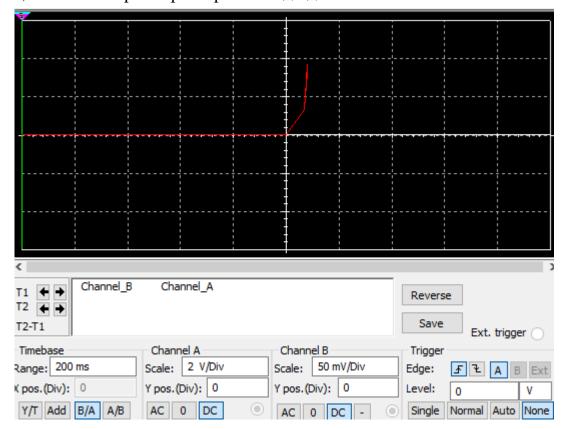


Рисунок 1.2. ВАХ випрямлювального діода

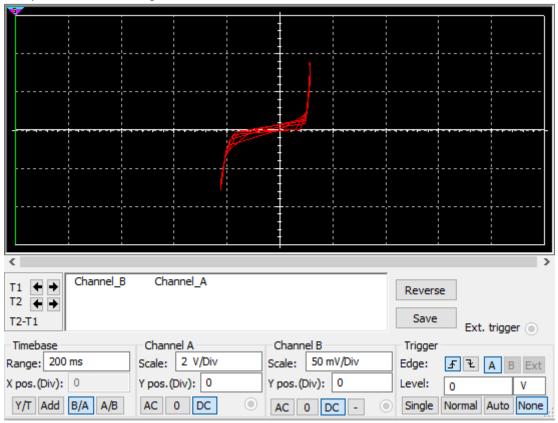


Рисунок 1.3. ВАХ стабілітрона

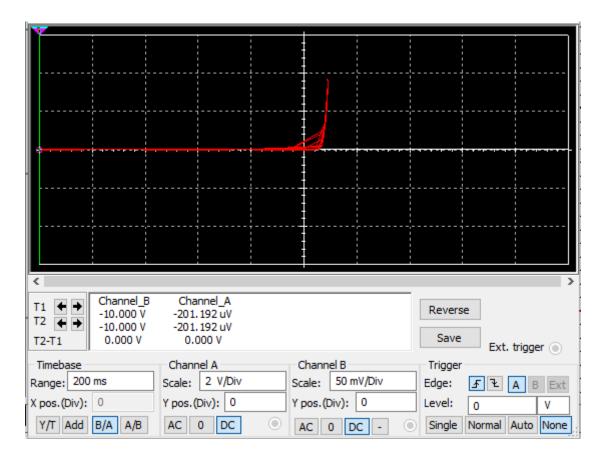


Рисунок 1.4. ВАХ світлодіода

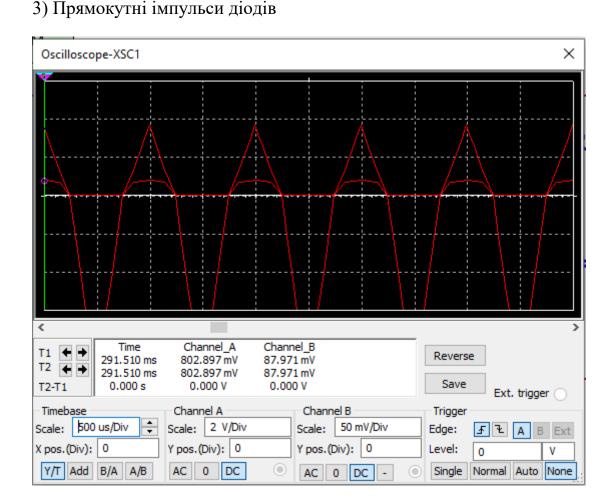
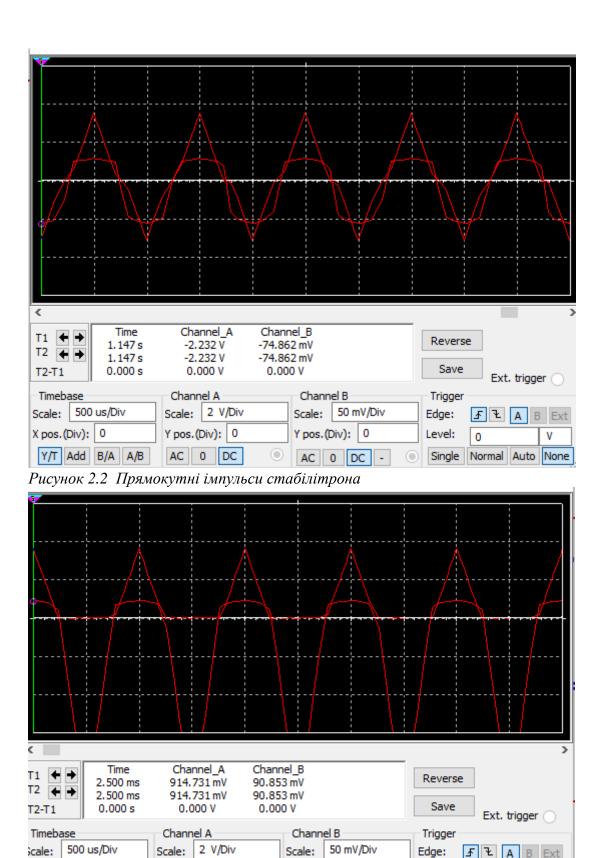


Рисунок 1.5. Прямокутні імпульси випрямлювального діода



Scale: 50 mV/Div

AC 0 DC -

Y pos.(Div): 0

Edge:

Level:

**₹ A** B Ext

Single Normal Auto None

Рисунок 2.3. Прямокутні імпульси світлодіода

(pos.(Div): 0

Y/T Add B/A A/B

Scale: 2 V/Div

Y pos.(Div): 0

AC 0 DC

#### Висновок

У ході роботи було проведено моделювання випрямлювального та світлодіодів, а також стабілітрона. Змодельовано ВАХ та прямокутні імпульси поданих пристроїв. Основним методом дослідження було використання осцилографа, який працював у режимі характериографа. Виконавець навчився користуватися базою діодів у NI Multisim, отримав загальні навички складання схем з ними.

## Список використаних джерел

- 1) Ю.О. Мягченко, Ю.М. Дулич, А.В.Хачатрян
- "Вивчення радіоелектронних схем методом комп'ютерного моделювання": Методичне видання. К.: 2006.
- 2) Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету / Упоряд. О.В.Слободянюк, Ю.О.Мягченко,
- В.М.Кравченко.- К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007.- 120 с.